Моделирование электрического пробоя методом диффузной границы

Пономарев А.С. под руководством Савенкова Е.Б., Зипуновой Е.В.

группа Б05-029, 4 курс МФТИ

05.03.2024



Содержание

- Введение
- Постановка задачи
- Теоретический анализ
- Численный анализ



Содержание

- Введение
- Постановка задачи
- Теоретический анализ
- Численный анализ



Физическое явление

Электрический пробой

Явление резкого возрастания тока в диэлектрике при приложении электрического напряжения выше критического.

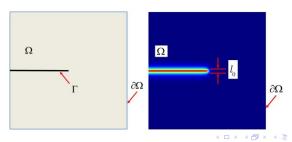
- Рассматриваем твердый диэлектрик
- Деградация диэлектрических свойств материала
- Процесс развивается в ограниченной зоне канале
- Сложная физическая природа



Модель типа диффузной границы

Вещество находится в разных фазах. Состояние вещества описывается гладкой функцией $\phi(\mathbf{x},t)$ – фазовым полем.

- ullet $\phi=1$ неповрежденная среда
- ullet $\phi=0$ полностью разрушенная среда
- ullet Зона $\phi \in (0,1)$ диффузная граница
- На разрушение среды тратится энергия



05.03.2024

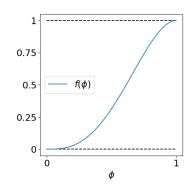
Модель, предложенная в работе [1]:

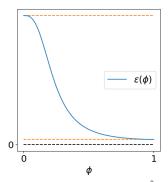
•
$$\pi=-rac{1}{2}\epsilon[\phi](
abla\Phi,
abla\Phi)+\Gamma\left(rac{1-f(\phi)}{l^2}+rac{1}{4}(
abla\phi,
abla\phi)
ight)$$
 – плотность свободной энергии

- Г энегрия роста пробоя на единицу длины
- / величина «размытия» пробоя
- ullet $\epsilon({\sf x},t)$ диэлектрическая проницаемость среды
- $f(\phi)$ интерполирующая функция



- ullet $\epsilon(\mathbf{x},t)=rac{\epsilon_0(\mathbf{x})}{f(\phi(\mathbf{x},t))+\delta}$ диэлектрическая проницаемость среды







Уравнения модели

• Уравнение электрического потенциала Ф:

$$\operatorname{div}(\epsilon[\phi]\nabla\Phi) = 0\tag{1}$$

• Уравнение фазового поля ϕ :

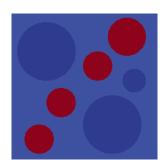
$$\frac{1}{m}\frac{\partial\phi}{\partial t} = \frac{1}{2}\epsilon'(\phi)(\nabla\Phi, \nabla\Phi) + \frac{\Gamma}{l^2}f'(\phi) + \frac{1}{2}\Gamma\triangle\phi \tag{2}$$

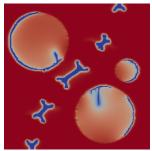
Свойства:

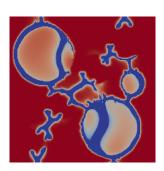
- ullet связанная система уравнений на ϕ и Φ ;
- ullet уравнение для ϕ типа Аллена-Кана, нелинейное.



Пример вычислительного эксперимента







Расчет из работы [2]



Цель работы

Цель работы

Исследовать качественные характеристики системы уравнений (1), (2): условия развития канала пробоя, границы применения разностной схемы.

Для этого будем рассматривать задачу в определенных начальных условиях, упрощающих ее, но позволяющих установить интересующие нас свойства.



Содержание

- Введение
- Постановка задачи
- Теоретический анализ
- Численный анализ



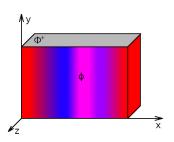
Одномерная задача

- Область $\Omega = [0,w]_x imes [0,h]_y imes I_z$ в форме параллелепипеда;
- $\phi(\mathbf{x},0) = \phi_0(\mathbf{x}) = \phi_0(x), \; \epsilon_0(\mathbf{x}) = \epsilon_0(x)$ не зависят от y и z;
- $\Phi|_{y=0} = \Phi^- \in \mathbb{R}, \ \Phi|_{y=h} = \Phi^+ \in \mathbb{R}.$

Решением является функция электрического потенциала

$$\Phi(\mathsf{x},t) = \Phi^- + \frac{y}{h}(\Phi^+ - \Phi^-)$$

Тогда уравнение на ϕ принимает вид



$$\frac{1}{m}\frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{1}{2}K_{\Phi}^{2}\epsilon'(\phi) + \frac{\Gamma}{l^{2}}f'(\phi) + \frac{1}{2}\Gamma\frac{\partial^{2}\phi}{\partial x^{2}}$$

$$\mathcal{K}_{\Phi} = rac{\Phi^+ - \Phi^-}{h}$$
. Будем считать $\epsilon_0 = \mathsf{const.}$



Содержание

- Введение
- Постановка задачи
- Теоретический анализ
- Численный анализ



Анализ положений равновесия

- Пробой может развиваться из малых возмущений свойств неповрежденной среды. Выясним условия развития.
- Рассмотрим положения равновесия вида $\phi(x,t)\equiv C$. Положению равновесия соответствует ноль C функции

$$\chi(\phi) = \frac{1}{2} K_{\Phi}^2 \epsilon'(\phi) + \frac{\Gamma}{l^2} f'(\phi)$$

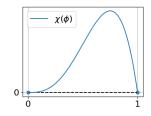
- Исследуем положения равновесия на устойчивость спектральным методом: к $\phi\equiv \mathcal{C}$ прибавим возмущение $\delta\phi=e^{\alpha t}\cos(\omega x)$, линеаризуем уравнение на $\delta\phi$
- $\chi(\phi)$ возрастает в $C\Longrightarrow$ равновесие неустойчиво; $\chi(\phi)$ убывает в $C\Longrightarrow$ равновесие устойчиво



Анализ положений равновесия

«Слабое» напряжение

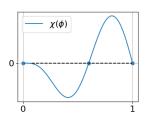
$$0 \leqslant \frac{K_{\Phi}^2 l^2 \epsilon_0}{2\Gamma} < \delta^2$$



 $\phi \equiv 0$ неустойчивое $\phi \equiv 1$ устойчивое

«Среднее» напряжение

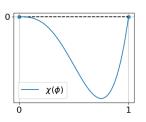
$$\delta^2 < \frac{\mathcal{K}_\Phi^2 l^2 \epsilon_0}{2\Gamma} < (1+\delta)^2 \qquad (1+\delta)^2 < \frac{\mathcal{K}_\Phi^2 l^2 \epsilon_0}{2\Gamma}$$



 $\phi \equiv 0$ устойчивое $\phi \equiv \mathrm{C}_3$ неустойчивое $\phi \equiv 1$ устойчивое

«Сильное» напряжение

$$(1+\delta)^2<rac{\mathcal{K}_{\Phi}^2l^2\epsilon_0}{2\mathsf{\Gamma}}$$



 $\phi \equiv 0$ устойчивое

 $\phi \equiv 1$ неустойчивое



Содержание

- Введение
- Постановка задачи
- Теоретический анализ
- Численный анализ



Разностная схема

Разностная задача

$$\begin{split} \frac{1}{m} \frac{\phi_a^{b+1} - \phi_a^b}{\tau} &= \frac{1}{2} K_\phi^2 \epsilon'(\phi_a^b) + \frac{\Gamma}{l^2} f'(\phi_a^b) + \frac{\Gamma}{2} \frac{\phi_{a+1}^b - 2\phi_a^b + \phi_{a-1}^b}{h^2} \\ \phi_a^0 &= \phi_0(ah); \quad \phi_0^b = \phi_l(b\tau); \quad \phi_{W/h}^b = \phi_r(b\tau) \end{split}$$

Сетка регулярная; au — шаг по времени, h — шаг по пространству.

Явная разностная схема первого порядка по времени, второго — по пространству.



Оценка устойчивости

• Рассмотрим возмущенное решение $\phi_a^b + \delta_a^b$. Линеаризуем уравнение на возмущение δ_a^b в точке $\phi_a^b = P$:

$$\delta_a^{b+1} = \delta_a^b + m\tau \left(\frac{1}{2} K_{\Phi}^2 \epsilon''(P) \delta_a^b + \frac{\Gamma}{l^2} f''(P) \delta_a^b + \frac{\Gamma}{2} \frac{\delta_{a+1}^b - 2\delta_a^b + \delta_{a-1}^b}{h^2} \right)$$

• Применим спектральный признак устойчивости:

$$1 > \lambda(\theta) = 1 + m\tau \left(\frac{1}{2} K_{\Phi}^2 \epsilon''(P) + \frac{\Gamma}{l^2} f''(P) - \frac{2\Gamma}{h^2} \sin^2 \frac{\theta}{2} \right)$$

• Исследуем вблизи 0.



Оценка устойчивости

Условие устойчивости

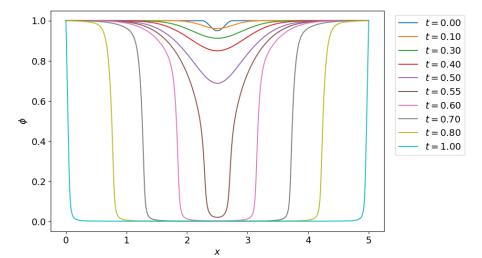
$$\tau \leqslant \frac{1}{\frac{2.2mK_{\Phi}^2\epsilon_0}{\delta^{5/3}} + \frac{2m\Gamma}{h^2}}$$

Упрощенное условие устойчивости

$$au \leqslant \min\left(rac{\delta^{5/3}}{4.4mK_{\Phi}^2\epsilon_0}, \; rac{h^2}{4m\Gamma}
ight)$$



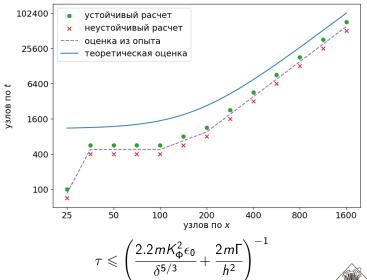
Вычисления: типичное решение



Узлов по измерениям: $n_{\chi}=10^3,\; n_t=10^5$

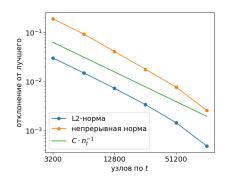


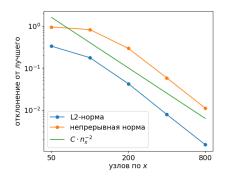
Вычисления: проверка устойчивости



Вычисления: проверка сходимости

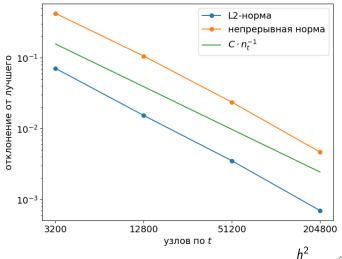
Проводится ряд вычислений, затем результаты сравниваются по норме с лучшим в ряду.







Вычисления: проверка сходимости

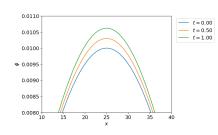


Здесь, согласно оценке устойчивости, $au=rac{n^2}{4m\Gamma}$



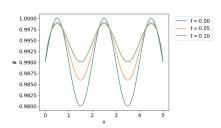
Вычисления: положения равновесия

$$0\leqslant rac{\mathcal{K}_{\Phi}^2 I^2 \epsilon_0}{2\Gamma} < \delta^2$$
 — «слабое» напряжение



$$\phi \equiv 0$$

неустой чивое



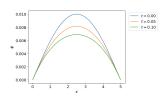
$$\phi \equiv 1$$

устойчивое

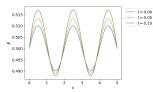


Вычисления: положения равновесия

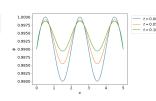
$$\delta^2 < rac{{ extstyle K_\Phi^2 I^2 \epsilon_0}}{2 \Gamma} < (1+\delta)^2$$
 — «среднее» напряжение



 $\phi \equiv 0$ устойчивое



 $\phi \equiv \mathcal{C}_3$ неустойчивое

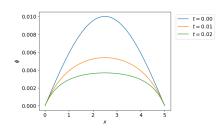


 $\phi\equiv 1$ устойчивое

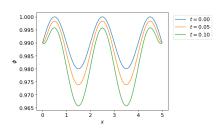


Вычисления: положения равновесия

$$(1+\delta)^2 < rac{K_\Phi^2 l^2 \epsilon_0}{2\Gamma}$$
 — «сильное» напряжение



$$\phi \equiv 0$$
 устойчивое



 $\phi \equiv 1$ неустойчивое



Свободная энергия

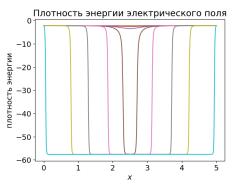
$$\Pi(t) = \int_{\Omega} \pi(x, t) dx$$

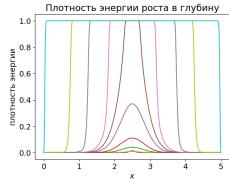
$$\pi(x, t) = \pi_1(x, t) + \pi_2(x, t) + \pi_3(x, t)$$

- $\pi_1(x,t)=-rac{K_\Phi^2}{2}\epsilon(\phi(x,t))$ плотность энергии электрического поля;
- $\pi_2(x,t) = \Gamma \frac{1 f(\phi(x,t))}{l^2}$ плотность энергии роста пробоя;
- ullet $\pi_3(x,t)=rac{\Gamma}{4}igg(rac{\partial \phi}{\partial x}(x,t)igg)^2$ плотность энергии образования граничной зоны пробоя



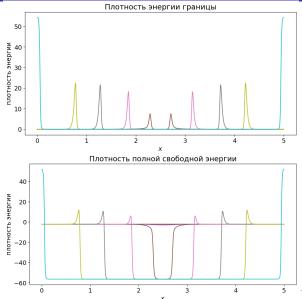
Вычисления: свободная энергия



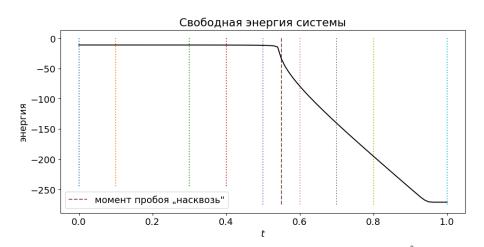




Вычисления: свободная энергия



Вычисления: свободная энергия



Литература



Е.В. Зипунова и Е.Б. Савенков. *О моделях диффузной границы* для описания динамики объектов высшей коразмерности. Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша. Москва, 2020.



Е.В. Зипунова, А.А. Кулешов и Е.Б. Савенков. Численное исследование модели фазового поля для описания развития канала электрического пробоя в неоднородной среде. Сибирский журнал индустриальной математики. 2024.



Спасибо за внимание

